



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

A92 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)

芯片代码：A072AJ-00

芯片厚度：240±20μm

管芯尺寸：720×720μm²

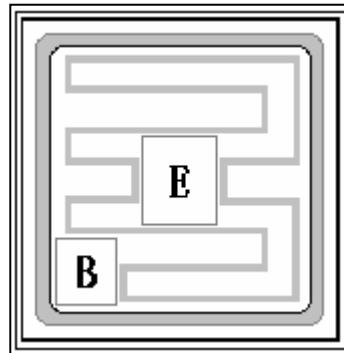
焊位尺寸：B 极 95×95μm²；E 极 100×100μm²

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：MPSA92 , HA92

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150

T_j——结温..... 150

P_C——集电极耗散功率..... 625mW

V_{CBO}——集电极—基极电压..... -300V

V_{CEO}——集电极—发射极电压..... -300V

V_{EBO}——发射极—基极电压..... -5V

I_C——集电极电流..... -500mA

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	-300			V	I _C =-100μA , I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-300			V	I _C =-1mA , I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-100μA , I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-250	nA	V _{CB} =-200V , I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-100	nA	V _{EB} =-3V , I _C =0
I _{CES}	集电极—发射极截止电流			-100	nA	V _{CE} =-300V , V _{BE} =0
h _{FE}	直流电流增益	25				V _{CE} =-10V , I _C =-1mA
		40		300		V _{CE} =-10V , I _C =-10mA
		25				V _{CE} =-10V , I _C =-30mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			-0.5	V	I _C =-20mA , I _B =-2mA
	集电极—发射极饱和电压			-1	V	I _C =-60mA , I _B =-6mA
	基极—发射极饱和电压			-0.9	V	I _C =-20mA , I _B =-2mA
f _T	特征频率	50			MHz	V _{CE} =-20V , I _C =-10mA , f=100MHz